



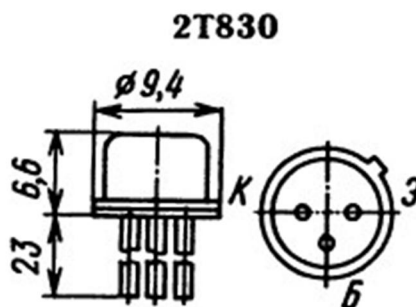
www.quartz1.ru  
www.quartz1.com

+7 (495) 7-8888-99; 963-61-20

сеть магазинов

**КВАРЦ**  
**радиолюбители**

## Транзистор КТ830А



Транзисторы КТ830А кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры р-п-р. Предназначены для применения в усилителях мощности, источниках вторичного электропитания, преобразователях.

Корпус 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г металлический со стеклянными изоляторами и гибкими выводами, транзисторы 2Т830В-1, 2Т830Г-1 бескорпусные с защитным покрытием и гибкими выводами.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 2 г, бескорпусного - не более 0,03 г.

Основные технические характеристики транзистора КТ830А:

Структура транзистора: р-п-р;

$P_{к\text{т max}}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 5 Вт;

$f_{гр}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 МГц;

$U_{кб\text{о max}}$  - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 35 В;

$U_{эб\text{о max}}$  - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;

$I_{к\text{ max}}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 2 А;

$I_{к\text{ и max}}$  - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 4 А;

$I_{к\text{б\text{o}}}$  - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 100 мкА (35В);

$h_{21э}$  - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: более 20;

$R_{кэ\text{ нас}}$  - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1,2 Ом